Centre Bukodan S.B.A.Y.O. Al Hoceima 5-mail : libreirie almanaz@gmail.com

Université Mohammed 1" Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima (ENSAH)



Année : 2013-2014 Niveau: CP2

Durée: theuresomin Jeudi 05 juin 2014

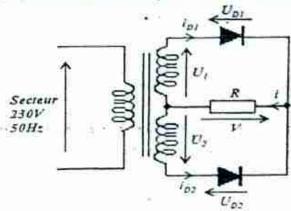
# Electronique Analogique (DS2)

## Question de cours (3pts)

Interpréter l'effet transistor.

Exercice I (7pts)

Un transformateur à point milieu possède au secondaire deux enroulements ayant le même nombre de spires. On branche au secondaire du transformateur un pont redresseur constitué de deux diodes.



a charge du redresseur est une résistance R et les diodes sont supposées parfaites.

a tension  $U_1$  est sinusofdale alternative de la forme :  $U_1(t) = 10\sqrt{2}sin(\omega t)$ 

. Quel est l'état des diodes quand  $U_1 > 0$ , et quand  $U_1 < 0$ ?

Tracer, en les justifiant, en concordance de temps V, Up1. Up2. i. ip1 et ip2.

on donne : R=1012

Calculer les valeurs moyennes suivantes : (V), (i), (i<sub>D1</sub>) et (i<sub>D2</sub>).

Montrer que :  $V_{eff} = U_{1eff}$  .

On rappelle que la valeur efficace est par définition :  $V_{eff} = \sqrt{\langle V^2(t) \rangle}$ . En déduire les valeurs efficaces des courants : ieff, loieff et lozeff

Calculer la puissance consommée par la résistance.

. On branche un condensateur en parallèle avec la résistance.

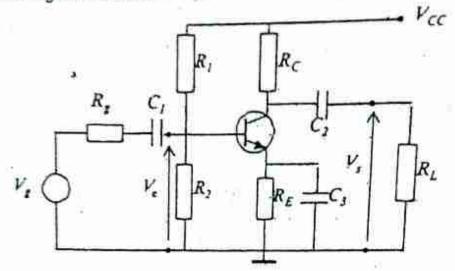
2. Donner l'allure de la tension aux bornes de la résistance R.

b. Calculer la capacité du condensateur pour avoir un taux d'ondulation de la tension de 10%.

Tournez la page 5VP

### Exercice II (10pts)

Soit l'amplificateur de la figure ci-dessous :



Données :

Résistances:  $R_1 = 80K\Omega$ ,  $R_2 = 40K\Omega$ ,  $R_C = 4K\Omega$ ,  $R_E = 3.3K\Omega$ 

Transistors: Gain en courant  $\beta$  (en continu) =  $h_{21}$  (en petites variations) = 100.

 $h_{22}$  est négligée, tension de la jonction base-émetteur :  $V_{BE} = 0.7V$ 

Alimentation:

 $V_{CC} = 12V$ .

Charge:

 $R_L = 1K\Omega$ 

#### L Etude statique :

1. De Quel type d'amplificateur s'agit-il?

En supposant que le courant de la base, est très faible devant la courant qui traverse le pont (R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>)
calculer les potentiels V<sub>BM</sub> et V<sub>EM</sub>.

Déterminer les coordonnées du point du fonctionnement Q(ICQ, VCEQ, IBQ et VBEQ).

#### II. Etude dynamique :

A.

Tracer le schéma équivalent en régime variable de l'amplificateur.

2. Donner les expressions du gain en tension Av., de l'impédance d'entrée Z, et l'impédance de sortie Z,

B. Cette fois, la résistance de l'émetteur, R<sub>E</sub>, est non découplée

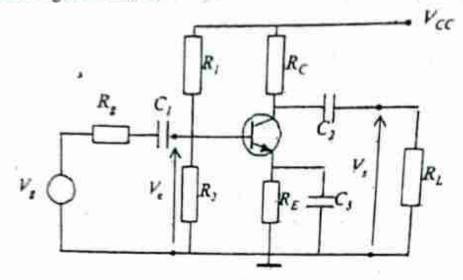
Tracer le schema équivalent en régime variable de l'amplificateur.

 Donner les nouvelles expressions du gain en tension A<sub>V</sub>, de l'impédance d'entrée Z<sub>e</sub> et l'impédance de sortie Z<sub>e</sub>.

Quel est l'intérêt du découplage de l'émetteur?

## Exercice II (10pts)

Soit l'amplificateur de la figure ci-dessous :



Données :

Résistances:  $R_1 = 80 K\Omega$ ,  $R_2 = 40 K\Omega$ ,  $R_C = 4 K\Omega$ ,  $R_E = 3.3 K\Omega$ 

Transistors: Gain en courant  $\beta$  (en continu) =  $h_{21}$  (en petites variations) = 100.

 $h_{22}$  est négligée, tension de la jonction base-émetteur :  $V_{BE} = 0.7V$ 

Alimentation:

 $V_{CC} = 12V$ .

Charge:

 $R_L = 1K\Omega$ 

### I. Etude statique :

1. De Quel type d'amplificateur s'agit-il?

En supposant que le courant de la base, est très faible devant la courant qui traverse le pont (R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> calculer les potentiels V<sub>SM</sub> et V<sub>SM</sub>.

Déterminer les coordonnées du point du fonctionnement Q(I<sub>CQ</sub>, V<sub>CEQ</sub>, I<sub>BQ</sub> et V<sub>BEQ</sub>).

### IL Etude dynamique :

A.

Tracer le schéma équivalent en régime variable de l'amplificateur.

2. Donner les expressions du gain en tension Ay, de l'impédance d'entrée Z, et l'impédance de sortie Z,

B. Cette fois, la résistance de l'émetteur,  $R_E$ , est non découplée

1. Traces le schema équivalent en régime variable de l'amplificateur.

 Donner les nouvelles expressions du gain en tension A<sub>V</sub>, de l'impédance d'entrée Z<sub>e</sub> et l'impédance de sortie Z<sub>e</sub>.

3. Quel est l'intérêt du découplage de l'émetteur ?

BRAIRIE AL-MARKAZ

otre Bukidan S.B.A.Y.O. Al Hoceim Examen - ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

sell librairie simarkaz@gmail.com

2 année CP - Année 2015-2016

Jeudl 09 fuin 2016, disrée 2h

# Questions de cours : (apts)

Interpréter l'effet transistor (transistor bipolaire).

2. Expliquer le principe de fonctionnement du transjistor JFET.

Exercice 1: (4pts)

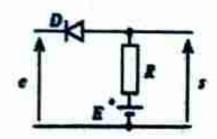
On dispose d'un générateur GBF qui délivér une tension  $e(t) = 10sin(\omega t)$ .

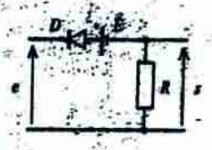
Les sources délivrent une tension continue E = 5V,  $E_1 = 6V$  et  $E_2 = 4V$ .

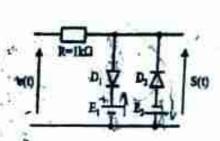
La diode D est idéale.

Les diodes  $D_1$  et  $D_2$  sont représentés auf Mars modèles à seuil  $V_1 = 0.7V$ .

Tracer, en justifiant votre reponse, la forme de la tension de sortie en fonction du temps s(t).







Exercice 2: (6pts)

On considère le montage collecteur commun de la figure ci-contre. On suppose que le transister est polarisé correctement avec un point de fonctionnement de coordonnées : (VCER ICEN).

- 1. Donner le schéma dynamique équivalent du montage.
- 2. Déterminer, à vide (sans charge), l'expréssion :
  - a) du gain en tension Ay,
  - b) du gain en courant A
  - c) de l'impédance d'entrée du montage Ze,
  - d) de l'impédance de sortie Z,
- En déduire l'expression du gain en tension du montage en charge. Conclure ?

